

トランジスタ

2SA963

2SA963

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形/Si PNP Epitaxial Planar

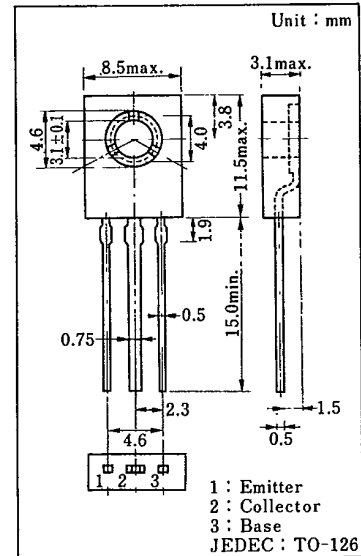
低周波電力増幅用/AF Power Amplifier
2SC2209 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with
2SC2209

■ 特徴/Features

- コレクタ損失が大きい。/Large P_c
- 2SC2209 とコンプリメンタリペアで出力 4~5W が得られます。/
4~5W output in complementary pair with 2SC2209

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	40	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	3	A
コレクタ電流	$-I_C$	1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_c	10	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

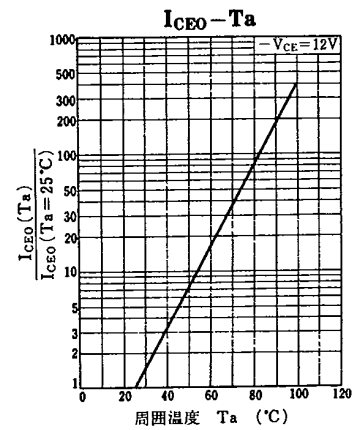
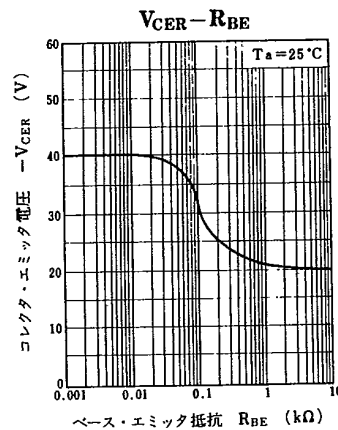
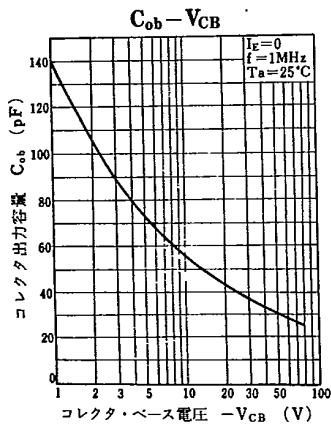
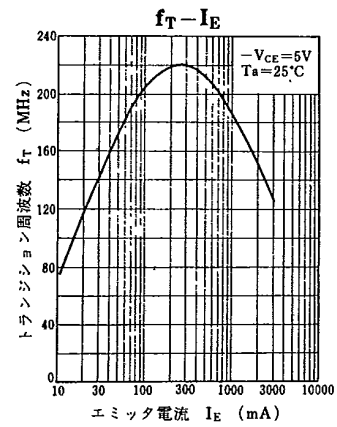
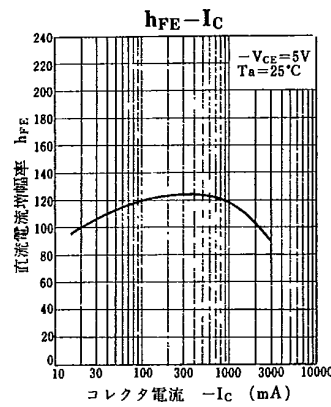
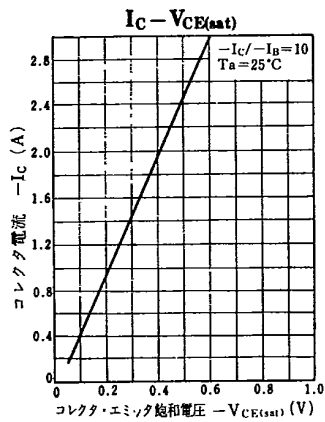
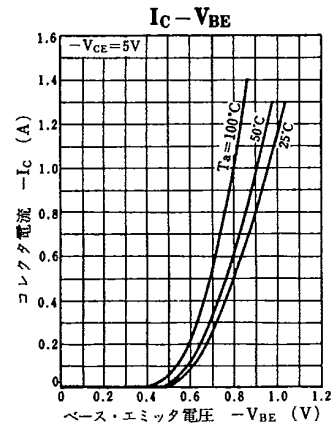
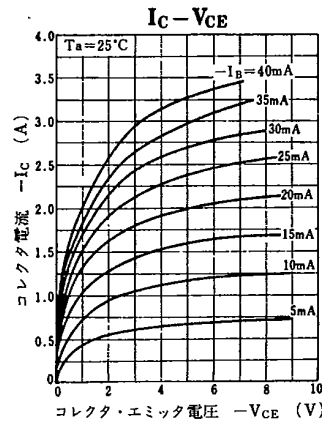
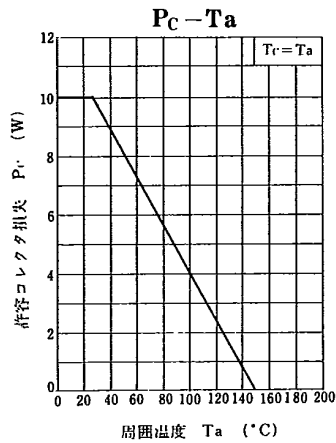
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 20\text{ V}, I_E = 0$			1	μA
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE} = 10\text{ V}, I_B = 0$			100	μA
エミッタしや断電流	$-I_{EBO}$	$-V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			10	μA
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 1\text{ mA}, I_E = 0$	50			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 2\text{ mA}, I_B = 0$	40			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 1\text{ A}$	50	120	220	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 1.5\text{ A}, -I_B = 150\text{ mA}$			1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C = 2\text{ A}, -I_B = 0.2\text{ A}$			1.5	V
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 0.5\text{ A}$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		70		pF

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	P	Q	R
h_{FE}	50~100	80~160	120~220

トランジスタ

T-33-17 2SA963



トランジスタ

T-33-17

2SA963

